⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-37114

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和60年(1985)2月26日

H 01 G 9/05 B-7435-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

固体電解コンデンサ

到特 願 昭58-144374

御出 願 昭58(1983)8月9日

79発明 者 小 林 征男

東京都世田谷区玉川4-19-14

砂発 明 者 内 藤 四発 明 川上

一 美

横浜市戸塚区原宿町1151-2

総一郎

川崎市中原区北谷町95-1

①出 願 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門1丁目13番9号

②代 理 弁理士 菊地 精一

1. 発明の名称

固体難解コンデンサ

2. 特許請求の範囲

一般式

で表わされるくり返し単位を有する高分子化合物 にドーパントをドープして得られる電導性高分子 化合物を、固体電解質とすることを特徴とする因 体電解コンデンサ。.

3. 発明の詳細な説明

本発用は、一般式(I)式で表わされるくり返 し単位を有する高分子化合物にドーパントをドー プレで行られる預測性高分子化合物を固体電解質 とする固体電解コンデンサに関する。

固体電解コンデンサは簡値酸化皮膜を有するア ルミニウム、タンタルなどの皮膜形成金属に固体 電解数を付着した構造を有している。従来のこの 種の固体コンデンサの固体電解質には主に硝酸マ ンガンの熱分解により形成される二酸化マンガン が用いられている。しかし、この熱分解の際に要 する高熱と発生するNOェガスの酸化作用などに よって誘環体であるアルミニウム、タンタルなど の金属酸化皮膜の損傷があり、そのため耐電圧は 低下し、もれ電流が大きくなり、誘電特性を劣化 させるなど値めて大きな欠点がある。また、再化 成という工程も必要である。

これらの欠点を補うため、高熱を付加せずに固 体 雷 解 質 図 を 形 成 す る 方 法 、 つ ま り 髙 電 導 性 の 有 機半導体材料を固体電解質とする方法が試みられ ている。その例としては、特周昭52-79255 号公 . 組に記載されている 7,7.8,8-テトラシアノキノ ジメタン(TCNQ)醋塩を含む饲料性高血合体 組成物を固体電解質として含む固体電解コンデン サ、特開館58- 17609号公報に記載されている N-n-プロピルイソキノリンと 7.7.8.8-テト ラシアノキノジメタンからなる鉛塩を固体電解コ ンデンサが知られている。これら T C N Q 錯 塩化合物は 展 板 酸 化 皮 護 と の 付 着 性 に 劣 り 、 電 導 底 も 10 ³ ~ 10 ² S・ cu⁻¹ と 不 十 分 で あ る た め 、 コ ン デ ン サ の 容 量 値 は 小 さ く 関 密 損 失 も 大 き い 。 ま た 敷 的 経 時 的 な 安 定 性 も 劣 り 信 類 件 が 死 い 。

本発明の目的は、上述した従来の欠点を解決するため、電導度が高く、誘電体皮蔵との付着性のよい有機半導体を固体電解質に用いた固体電解コンデンサを提供することにある。

本発明は固体電解質に(I)式で表わされるくり返し単位を有する高分子化合物にドーパントをドープして得られる電準性高分子化合物を用い、ることを特徴とする固体電解コンデンサは従来の無機酸化半導体や有機半導体を用いた固体電解コンデンサに比して容量、誘電過失、軽時安定性において翌しく優れた性能を有している。

以下本発明について詳細に説明する。

本発明で用いられる高分子化合物は下記の構造を有するものであり、

あるいは、BFI、CLOI、PFI、ASFI などのアニオンを電気化学的方法を用いてドープ することによって電気伝導度を10~~102 S・ cn~まで高めることができる。

したがって一般式(I) 式で表わされる、くり 返し単位を有する高分子化合物、 例えばポリチオフェン・ポリピロール・ポリフラン等にドーパントをドープして何られる電源性高分子化合物を健
歴質に用いれば下配のごとき効果が得られる。

① 高温加熱をすることなりに健保質層を形成できるので層板の酸化皮膜の銀像がなく、前條のための異複酸化(再化成)を行なう必要がない。そのため定格電圧を従来の数倍にでき、同容量、同定格電圧のコンデンサをを得るのに形状を小型化できる。

- ② もれ電流が小さい。
- ② 高耐圧のコンデンサを作製できる。
- ④ 電解質の程導度が ~102 S・cm と十分に高いため、グラファイトなどの導電図を設ける必要がなく、工程が簡略化される。本発明による図

R R' ただし
R, R' はアルギル基またはH
X は O、S または N R"
R" はアルギル基または H

代表例としては、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリフランがあげられる。これら高分子化合物の製造方法は特に限定されるものではないが例えばポリチオフェンについては J. Polym. - Soi. Polyn. tett. Ed., 18. 9(1980); J. Electroanal, ohem., 135, 173(1982) Makromol. ohem., Rapid common. 2,551 (1981), ポリピロールについては J. C. S. ohem. oompun., 854 (1979) 及び J. polym. Soi. polym. Lett. Ed. 20. 107(1982). ポリフランについては J. Electroanal. chem., 135, 173(1982) 等の方法によって製造することができる。

また、これら商分子化合物にl2、Br2、SO2、As Fs 、Sb Fs 、などの電子受容体を化学的方法を用いて、ドープすることによって、

体 電解 コンデンサの 級略 を第 1 図に 示した。 アルミニウム、 タンタル、ニオブ 等の 弁作用 金属 を 陽極 酸化 し、 配 化皮膜上に 電解 暦 を 形成 する。 さらに 観ペーストで 陰極を取り出し、 ケースに入れ 樹脂 等で 密封外装して 固体 電解 コンデンサを 得る。

以下実施例を示し、本発明を詳和に説明する。 実施例 1

実施例2

実施例1同様に關係酸化したT8 索子を正権、 白金を負債として、電解液にチオフェンモノマー

特開昭60-37114(3)

を 0.01 M溶解させた 0.1M Bu 4 NBF4 - CH3 CNを使用して電解重合を行ない、Ta 系子上にBF4 をドープしたポリチオフェンの電解質問を形成し、固体電解コンデンサを作成した。

BF4 をドープしたポリチオフェンの電準度は 10² S・cm⁴ であった。

夹饰 例 3

実施例2において、チオフェンモノマーの代り にピロールモノマーを使用して電解質面を形成し 四級に関体電解コンデンサを作成した。

BF4 をドープしたポリピロールの確準度は 10² S・cs⁻¹ であった。

実施例 4

実施例 2 において、チオフェンモノマーの代り にフランモノマーを使用して電解質層を形成し、 関縁に固体電解コンデンサを作成した。

BF4 をドープしたポリフランの電楽度は 10S・cn-1 であった。

実施例1と同様な関極酸化したTa 素子を用いた従来の二酸化マンガンを電解質とする固体電解

コンデンサの比較例1と実施例1,2,3の特性 を比較したものを第1数に示す。

			第 1 表			
		容量(ルド)	tan (X)	定格常圧(V)	られで流	逆耐危圧(V)
实施例	1	1.00	0.98	50	10mAIX下 a150V	60V 以上
	2	0.99	0.84	50	10nAIX'F at50V	500 以上
	3	0.99	9.95	50	10nALX TF	50V DL .
	4	Ø, 98	1.00	50	10nAIX F	400 以上
比较例	-1	1,00	1.02	25	10nALXTF 8125V	10V X.F

第1表から明らかなように、本発的によるドーパントをドープした電影性高分子化合物を電解質とする固体電解コンデンサに比して誘電損失もれ電解コンデンサを作成することができる。また、本発明による固体電解コンデンサの登量×定格電圧の値は二酸化マンガンを用いた関係によるによる。できる。できる。と称できる。と称できる。

上記実施例では、素子の金履はタンタル焼結体

であったが、他のアルミニウム、ニオブでもよく、 形状も粉末焼結体に限らない。

4. 図面の簡単な説明

第.1 図は本発明による関体電解コンデンサの一例を示す所画図である。

1 ··· T a , A 止等の金属焼結体・

2 … 酸化皮膜

3 … 冠導性高分子化合物

4…遊聞ペースト

5 … 半田

6 … ケースおよび 降植

7 --- 風 額

8 … 封口树脂

特 杵 出賴人 昭和第三株式会社

代型人 弁理士 菊 地 精 一

第1図

